



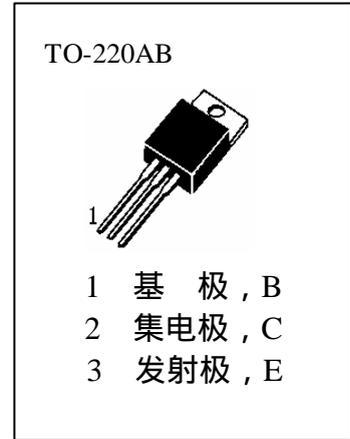
主要用途

高压快速开关

外形图及引脚排列

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-65~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散($T_c=25$).....	75W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	700V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	400V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	9V
I_C ——集电极电流(DC).....	4A
I_C ——集电极电流(脉冲).....	8A
I_B ——基极电流.....	2A



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	$I_C=10mA, I_B=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	$V_{EB}=9V, I_C=0$
$HFE(1)$	直流电流增益	10		40		$V_{CE}=5V, I_C=10A$
$HFE(2)$		8		40		$V_{CE}=5V, I_C=2A$
$V_{CE(sat1)}$	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	$I_C=1A, I_B=0.2A$
$V_{CE(sat2)}$				0.6	V	$I_C=2A, I_B=0.5A$
$V_{CE(sat3)}$				1	V	$I_C=4A, I_B=1A$
$V_{BE(sat1)}$	基极—发射极饱和电压			1.2	V	$I_C=1A, I_B=0.2A$
$V_{BE(sat2)}$				1.6	V	$I_C=2A, I_B=0.5A$
C_{ob}	共基极输出电容		65		pF	$V_{CB}=10V, f=0.1MHz$
f_T	特征频率	4			MHz	$V_{CE}=10V, I_C=0.5A$
t_{on}	导通时间			0.8	μS	} $V_{CC}=125V, I_C=2A$ $I_{B1}=-I_{B2}=0.4A$
t_{stg}	贮存时间			4	μS	
t_f	下降时间			0.9	μS	

分档： H1(10--16) H2(14--21) H3(19--26) H4(24--31) H5(29--40)



特性曲线

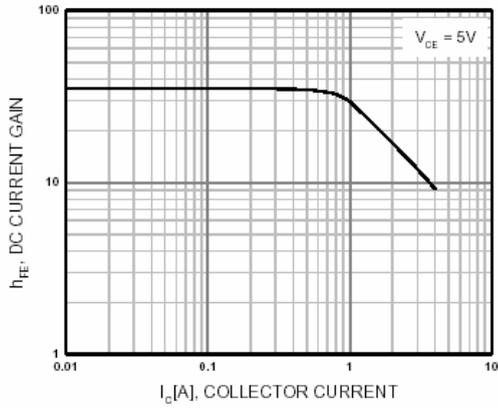


Figure 1. DC current Gain

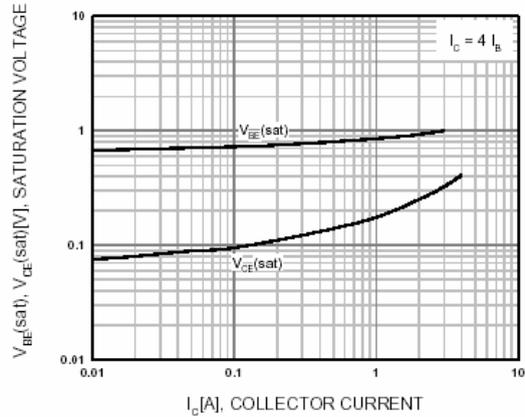


Figure 2. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage

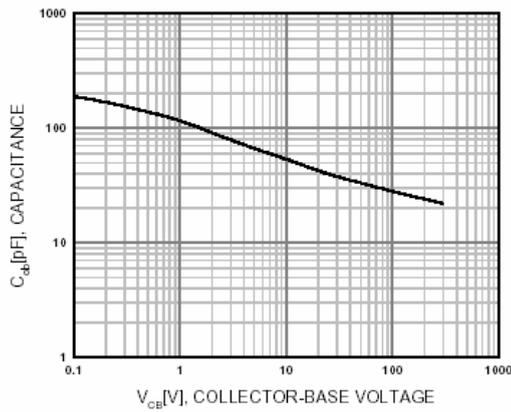


Figure 3. Collector Output Capacitance

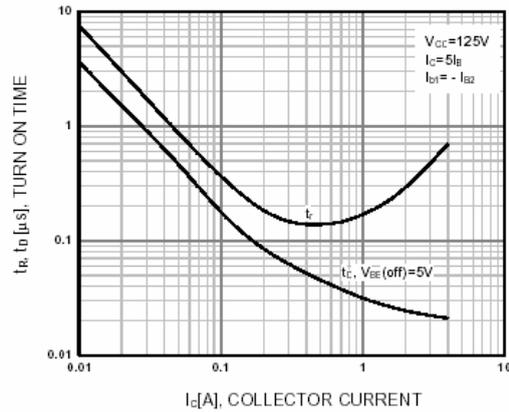


Figure 4. Turn On Time

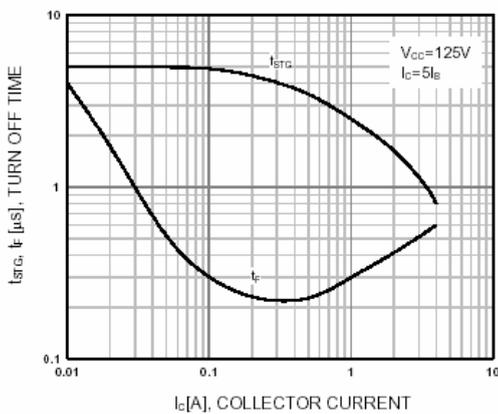


Figure 5. Turn Off Time

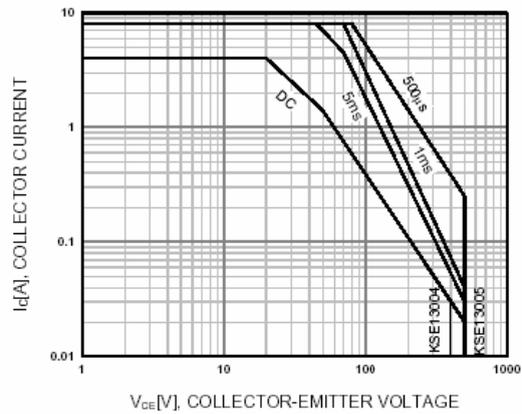


Figure 6. Safe Operating Area



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HE13005

对应国外型号
KSE13005

特性曲线

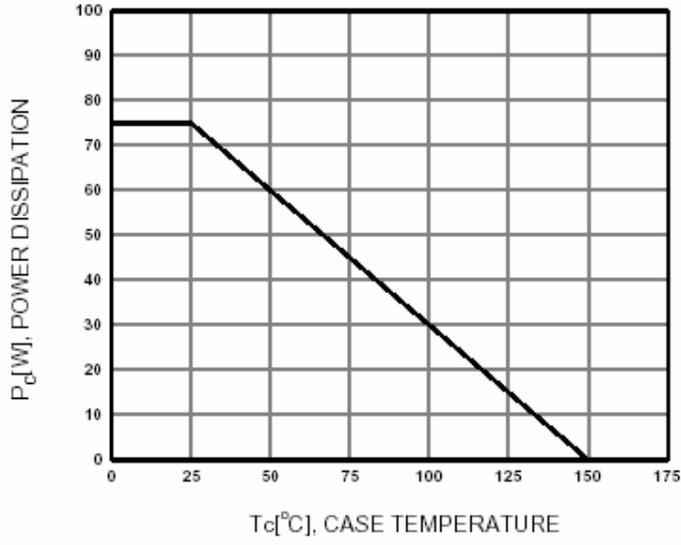


Figure 7. Power Derating